

公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会主催

第 30 回シンポジウム

「熱電・圧電関係エネルギーハーベスティング技術の最新動向」

共催 CVD 研究会, Cat-CVD 研究会

日時：2019年3月5日(火) 13:00～18:00 終了後、懇親会を開催します。

会場：東京大学 本郷キャンパス 工学部 4号館 3階 42講義室 (419号室)

参加費：化学工学会 CVD 反応分科会法人賛助会員(無料), 化学工学会 CVD 反応分科会個人会員(2,000円), 化学工学会 反応工学部会会員(3,000円), 化学工学会会員(4,000円), CVD 研究会会員(4,000円), Cat-CVD 研究会会員(4,000円), 非会員(10,000円), 学生(無料)

申込方法：下記の Web サイトよりお申し込み下さい。

<http://qq4q.biz/ewFe>

上記サイトにアクセスできない場合には、(1)氏名、(2)所属、(3)連絡先 E-mail、(4)参加資格(所属学会等)、(5)懇親会出欠を明記の上、cvd@scej.org までメールにてお申し込み下さい

申込締切：3月1日(金) ただし、定員(80名)になり次第締め切ります。

問い合わせ先：CVD 反応分科会事務局 E-mail：cvd@scej.org

開催趣旨

来る 5G による IoT 時代においてエネルギーハーベスティング (環境発電) 技術は各素子への電力供給として必要不可欠な技術です。また近年話題の SDGs (持続可能な開発目標) に対しても大きく貢献できる技術として注目されております。

今回のシンポジウムでは、本技術の中の振動発電及び温度差発電で重要な役割を果たす圧電素子及び熱電変換素子について、それぞれの分野の研究者の方々に基礎から応用まで色々な角度からご講演いただきます。各素子の機能材料には、現在 CVD 技術を用いて製膜されているものや、将来 CVD 技術が使われる可能性のあるものなど、多様なものが含まれております。皆さまのエネルギーハーベスティング技術に対する知見を深める機会になりましたら幸いです。

プログラム

12:30 受付開始

13:00～13:05 開会挨拶

13:05～14:05 (基調講演) 「プロセスで生きる熱電、プロセスで使う熱電」
舟橋 良次 氏 (産業技術総合研究所)

14:05～14:45 「CMOS プレーナプロセスで製造可能な微小熱電発電デバイス」
渡邊 孝信 氏 (早稲田大学)

14:45～15:00 休憩

15:00～15:40 「カーボンナノチューブ薄膜を用いた柔軟なエネルギーハーベスティングデバイス」
大野 雄高 氏 (名古屋大学)

- 15:40～16:20 「各種ピエゾ素子デバイスと将来展開（仮）」
後藤 隆幸 氏（太陽誘電株式会社）
- 16:20～16:35 休憩
- 16:35～17:15 「スパッタリング法による圧電材料薄膜の製造技術」
小林 宏樹 氏（アルバック株式会社）
- 17:15～17:55 「非鉛圧電体薄膜を用いた高効率 MEMS 振動発電素子」
吉村 武 氏（大阪府立大学）
- 17:55～18:00 閉会挨拶
- 18:00～19:30 懇親会 [会場：東京大学工学部 4 号館 3 階 44 講義室（401B 号室）]
(参加費 一般：2,000 円，学生：1,000 円)

詳細は、以下の URL も参照下さい。

<http://www2.scej.org/cre/cvd/index.html>

シンポジウムオーガナイザー

- 齊藤 丈靖（大阪府立大学）
三宅 雅人（奈良先端科学技術大学院大学）
筑根 敦弘（太陽日酸株式会社）

会場案内図：東京大学 本郷キャンパス 工学部 4 号館 3 階 42 講義室(419 号室)

